

## Technische Information / technical information



**Netz-Thyristor-Modul**  
Phase Control Thyristor Module

# TT250N

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG

### Key Parameters

$V_{DRM} / V_{RRM}$	1200 – 1800 V
$I_{TAVM}$	250 A ( $T_C=85\text{ °C}$ )
$I_{TSM}$	7000 A
$V_{T0}$	0,8 V
$r_T$	0,7 m $\Omega$
$R_{thJC}$	0,124 K/W
Base plate	50 mm
Weight	800 g



For type designation please refer to actual short form catalog

<http://www.ifbip.com/catalog>

### Merkmale

- Druckkontakt-Technologie für hohe Zuverlässigkeit
- Industrie-Standard-Gehäuse
- Elektrisch isolierte Bodenplatte

### Features

- Pressure contact technology for high reliability
- Industrial standard package
- Electrically insulated base plate

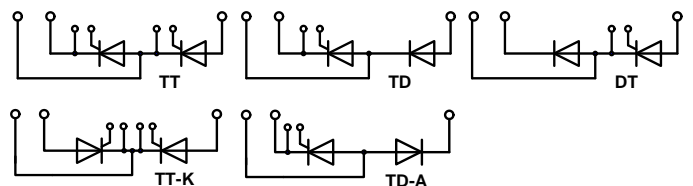
### Typische Anwendungen

- Sanftanlasser
- Gleichrichter für Antriebsapplikationen
- Kurzschließer-Applikationen
- Leistungssteller
- Gleichrichter für UPS
- Batterieladegleichrichter
- Statische Umschalter

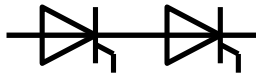
### Typical Applications

- Soft starters
- Rectifier for drives applications
- Crowbar applications
- Power controllers
- Rectifiers for UBS
- Battery chargers
- Static switches

	DMX code digit	DMX code digit quantity
content of customer DMX code	1..5	5
serial number	6..12	7
Internal production order number	13..20	8
datecode (production year)	21..22	2
datecode (production week)	23..24	2



[www.ifbip.com](http://www.ifbip.com)  
[support@infineon-bip.com](mailto:support@infineon-bip.com)



## Technische Information / technical information



**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**

# TT250N

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG

TT250N...

TD250N...

DT250N...

Kenndaten

### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

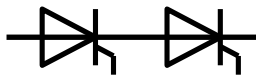
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1200 1600	1400 1800	V V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DSM}}$	1200 1600	1400 1800	V V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{RSM}}$	1300 1700	1500 1900	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		$I_{\text{TRMSM}}$		410	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 82^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$		250 261	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$	$I_{\text{TSM}}$		8.000 7.000	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$	$I^2t$		320.000 245.000	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$		150	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 <sup>th</sup> letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$		1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

### Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_{\text{T}} = 800\text{ A}$	$V_{\text{T}}$	max.	1,5	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{(TO)}}$	max.	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$r_{\text{T}}$	max.	0,7	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}$	$I_{\text{GT}}$	max.	200	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}$	$V_{\text{GT}}$	max.	2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max. max.	10 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max.	0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}, R_{\text{A}} = 1\ \Omega$	$I_{\text{H}}$	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10\ \Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20\ \mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max.	1200	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max.	50	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max.	3	$\mu\text{s}$

prepared by:	CD	date of publication:	29.01.13
approved by:	ML	revision:	3.1



## Technische Information / technical information



**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**

# TT250N

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG

### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties


Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}, I_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\ V, V_{DM} = 0,67\ V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\ V/\mu s, -di_T/dt = 10\ A/\mu s$ 5.Kennbuchstabe / 5 <sup>th</sup> letter O	$t_q$	typ.	250	$\mu s$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min RMS, f = 50 Hz, t = 1 sec	$V_{ISOL}$		3,0 3,6	kV kV

### Thermische Eigenschaften / Thermal properties

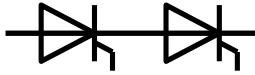
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\ sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\ sin$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	$R_{thJC}$	max.	0,065 0,130 0,062 0,124	K/W K/W K/W K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	$R_{thCH}$	max.	0,02 0,04	K/W K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$		125	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$		-40...+125	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		-40...+130	°C

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation internal insulation	Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140) Basic insulation (class 1, IEC61140)			AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$	M1		5	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$	M2		12	Nm
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46 244			A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight		G	typ.	800	g
Kriechstrecke creepage distance				17	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz			50	m/s <sup>2</sup>
	file-No.			E 83335	

Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



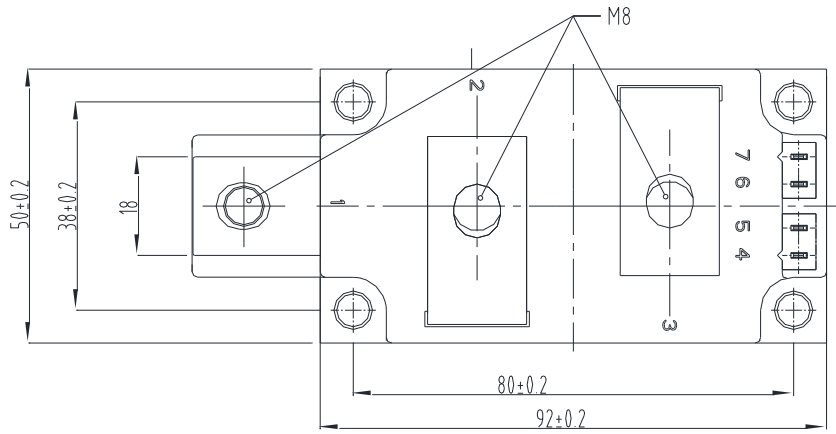
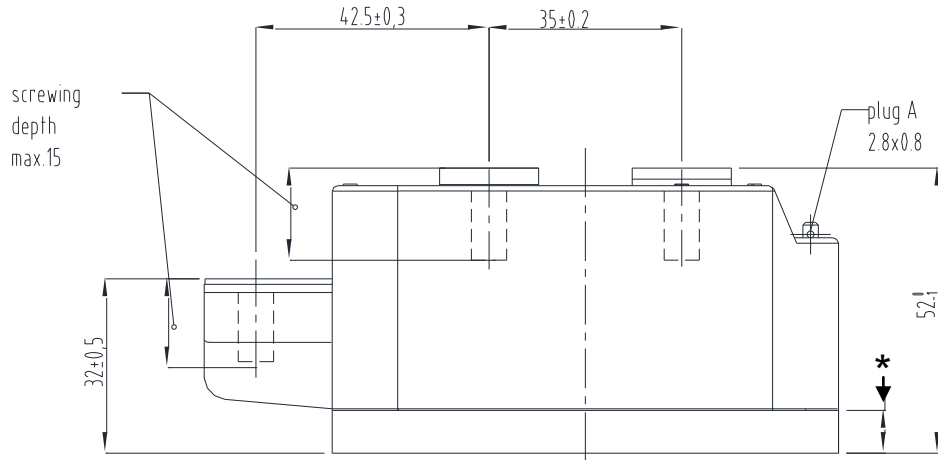
Technische Information /  
technical information



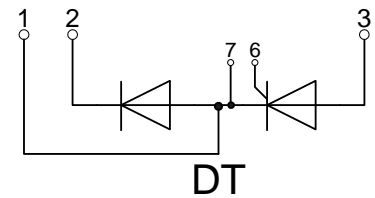
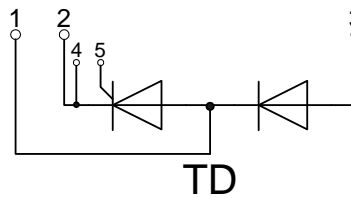
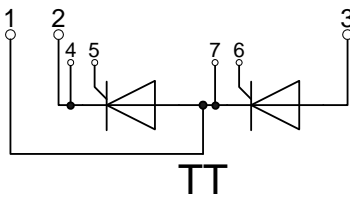
Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

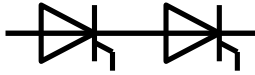
**TT250N**

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG



- \***
- 1200V: 8mm<sup>-0.2</sup>
  - 1400V: 8mm<sup>-0.2</sup>
  - 1600V: 8mm<sup>-0.2</sup>
  - 1800V: 10mm<sup>-0.2</sup>





Technische Information /  
technical information



Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TT250N**

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG

**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC**  
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC**

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [K/W]	0,0426	0,0429	0,0257	0,0097	0,0031		
$\tau_n$ [s]	3,06	0,61	0,11	0,008	0,0009		

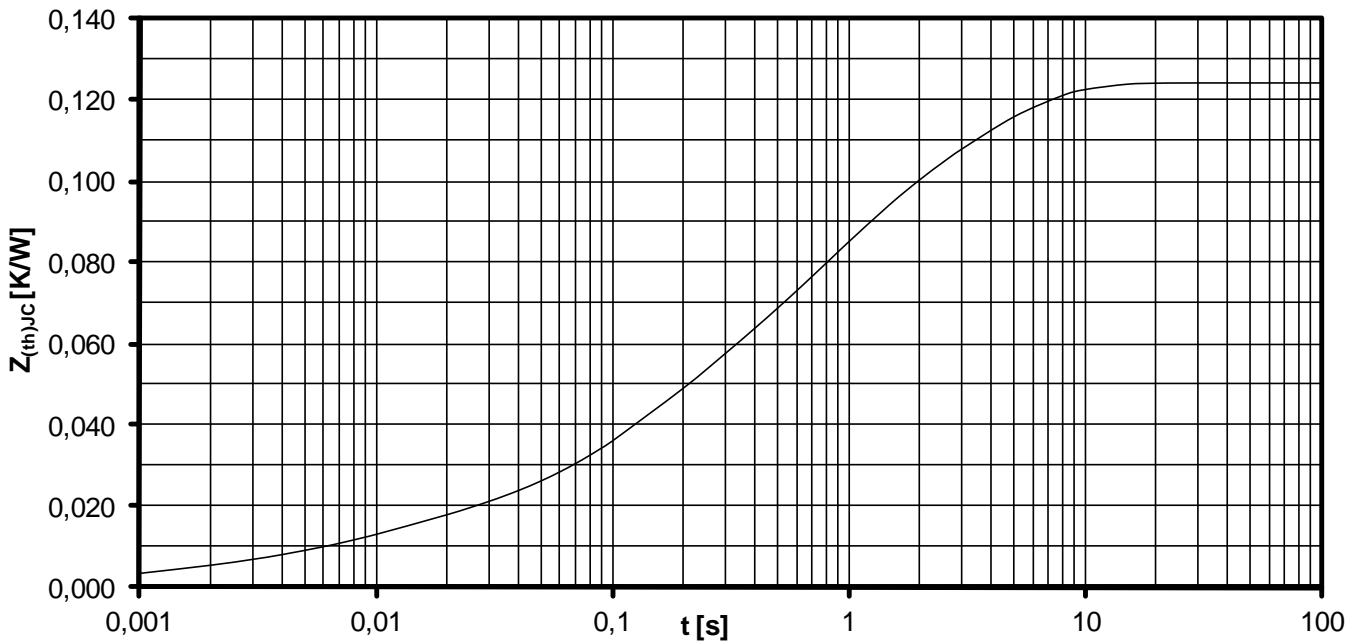
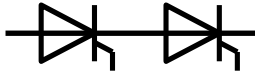
Analytische Funktion / Analytical function: 
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[ 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right]$$

**Erhöhung des  $Z_{th DC}$  bei Sinus und Rechteckströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln  $\Theta$**   
**Rise of  $Z_{th DC}$  for sinewave and rectangular current with different current conduction angles  $\Theta$**   
 $\Delta Z_{th \Theta rec} / \Delta Z_{th \Theta sin}$

	$\Theta = 180^\circ$	$\Theta = 120^\circ$	$\Theta = 90^\circ$	$\Theta = 60^\circ$	$\Theta = 30^\circ$
$\Delta Z_{th \Theta rec}$ [K/W]	0,01	0,0164	0,0212	0,0281	0,0405
$\Delta Z_{th \Theta sin}$ [K/W]	0,0069	0,0098	0,0136	0,0199	0,033

$$Z_{th \Theta rec} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta rec}$$

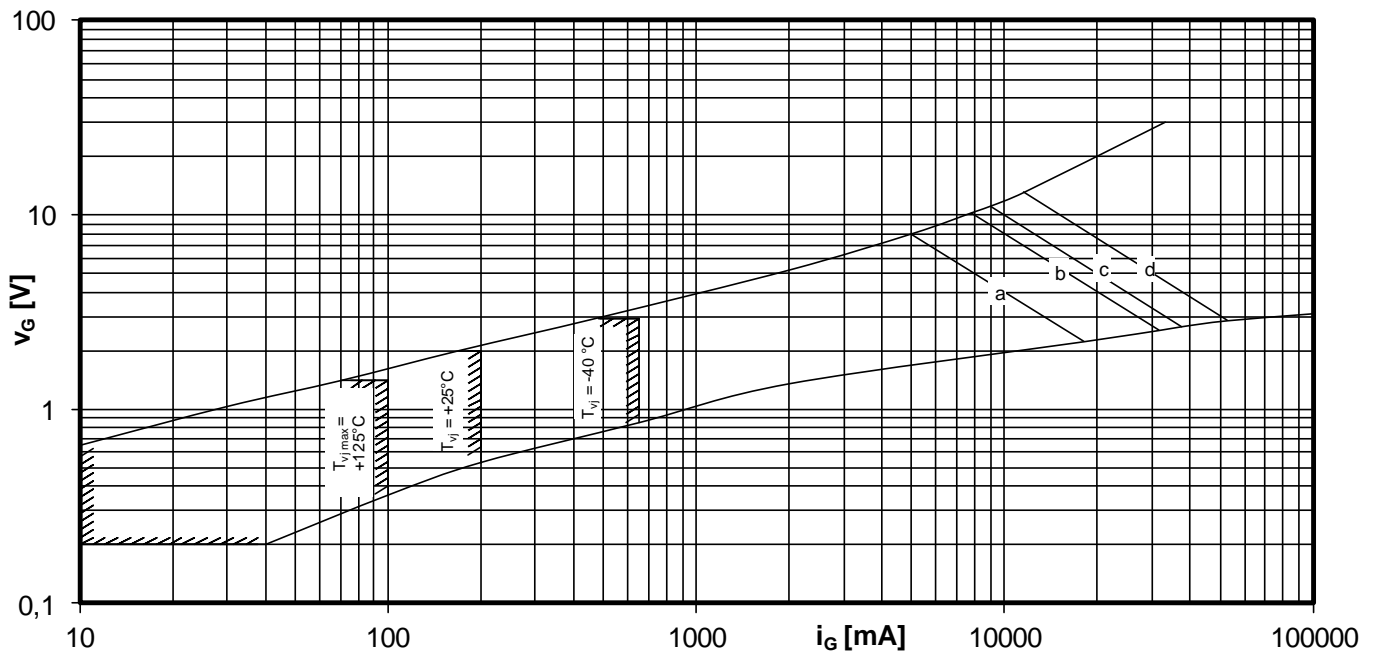
$$Z_{th \Theta sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta sin}$$



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm  $Z_{thJC} = f(t)$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

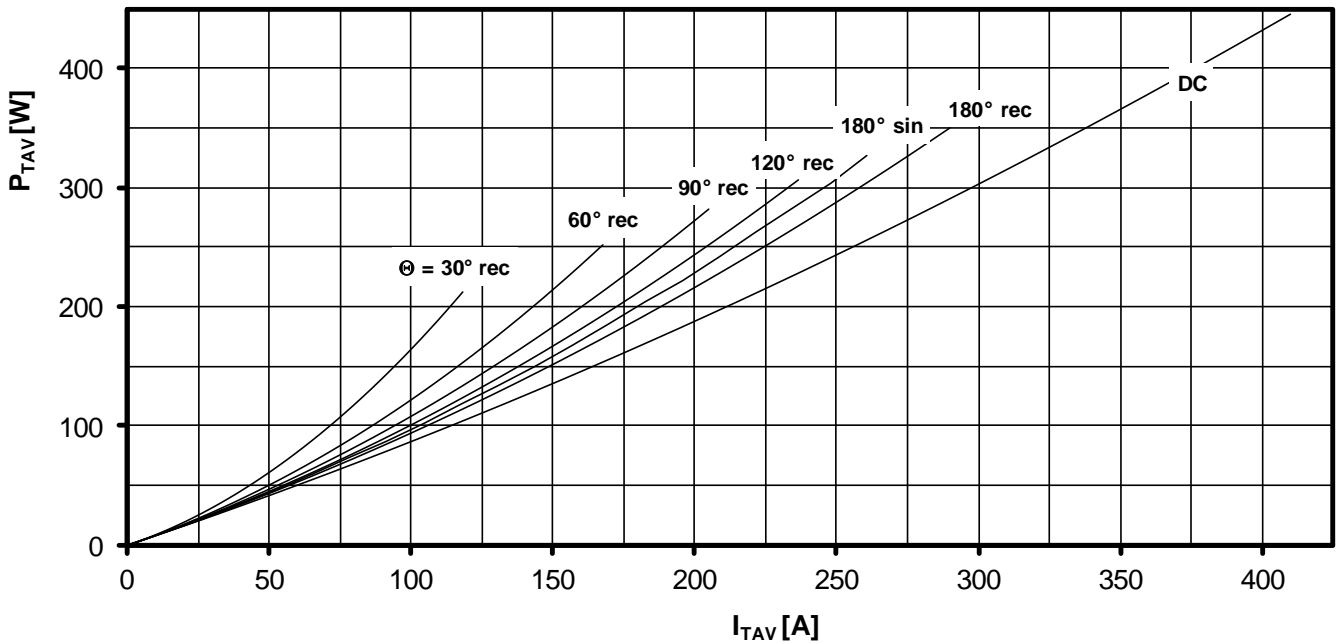
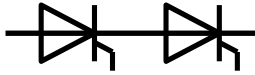
Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



Steuercharakteristik  $v_G = f(i_G)$  mit Zündbereichen für  $V_D = 12\text{ V}$   
Gate characteristic  $v_G = f(i_G)$  with triggering area for  $V_D = 12\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation  $P_{GM} = f(t_g)$  :

a - 40 W/10ms   b - 80 W/1ms   c - 100 W/0,5ms   d - 150 W/0,1ms

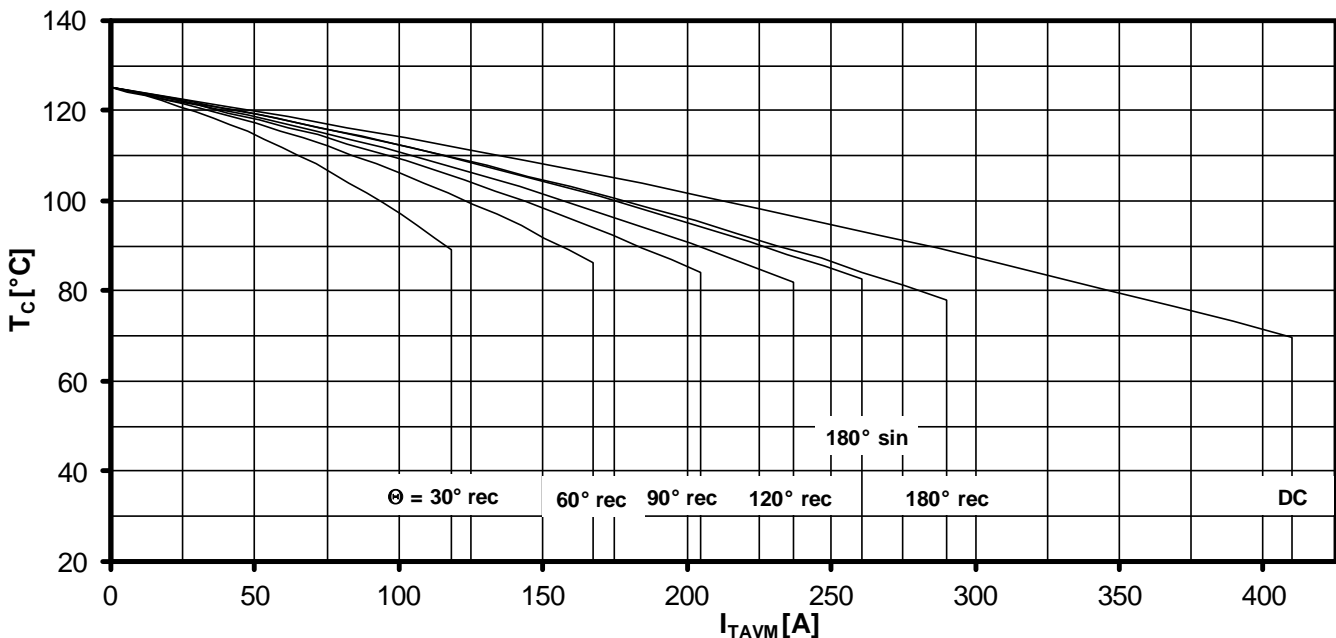


Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)  
Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\Theta$

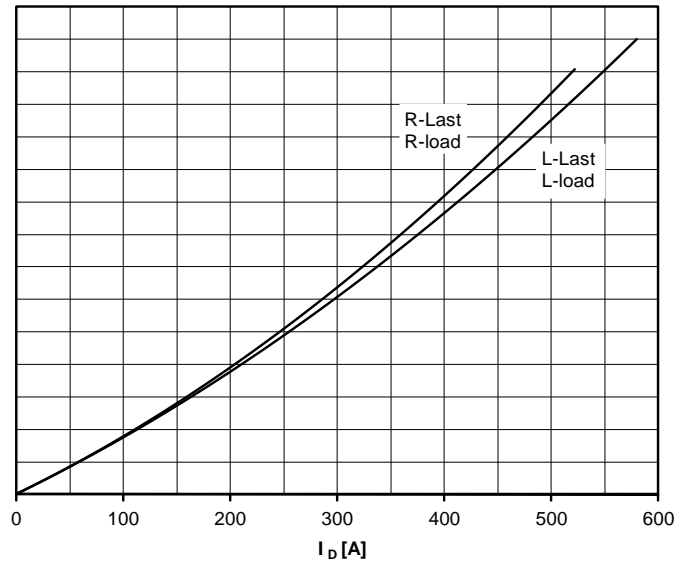
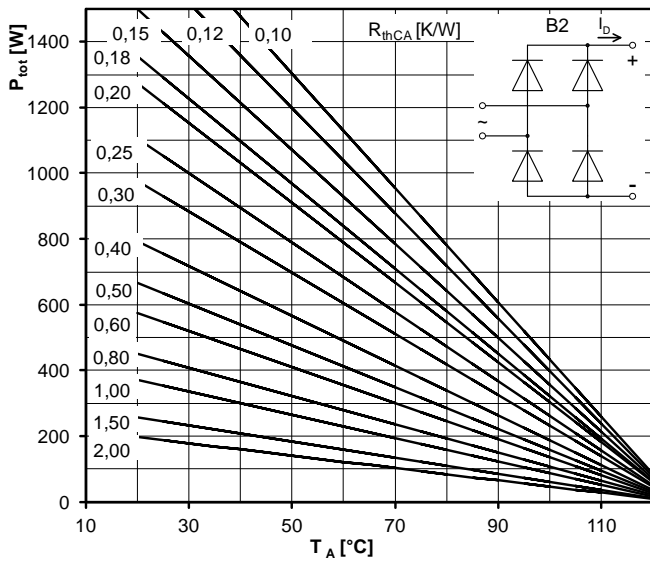
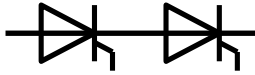


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_C = f(I_{TAVM})$

Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)  
Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / Current conduction angle  $\Theta$



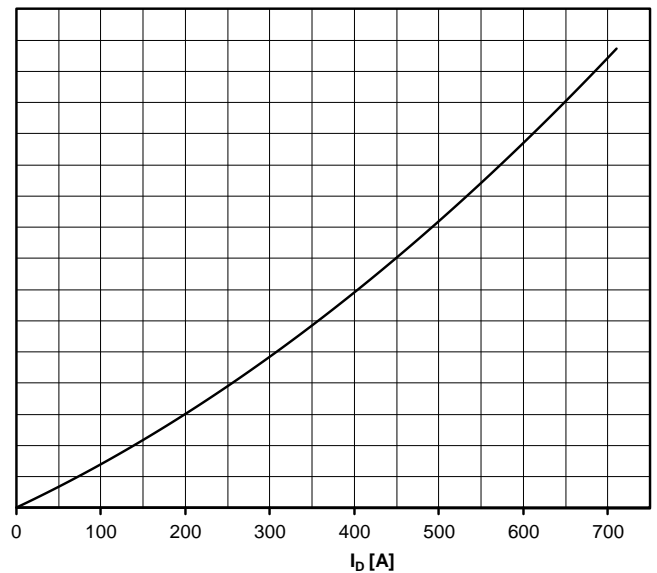
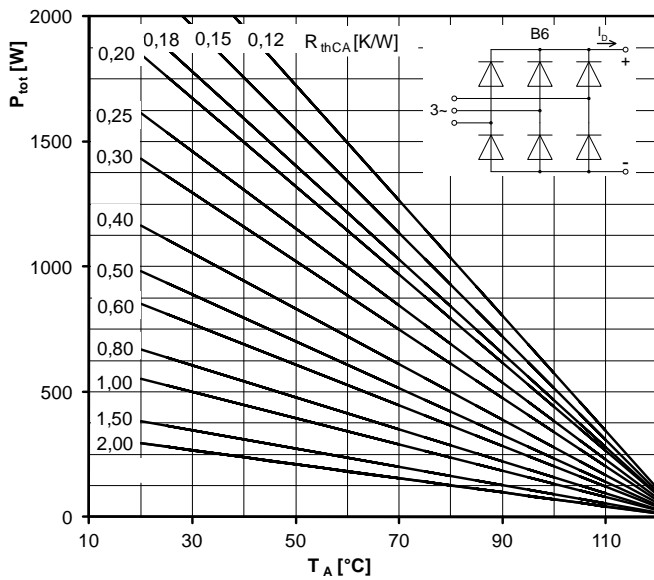
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current  $I_D$

B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

Wärmewiderstand pro Element zwischen den Gehäusen und Umgebung /  
Thermal resistance per chip cases to ambient  $R_{thCA}$



Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current  $I_D$

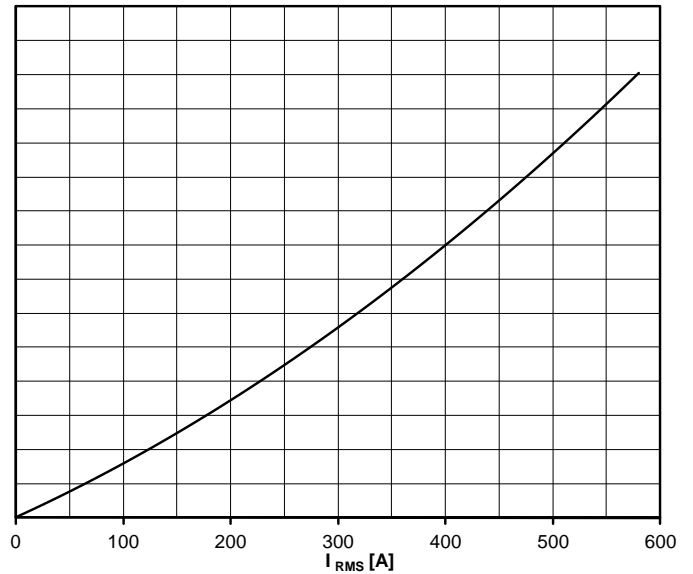
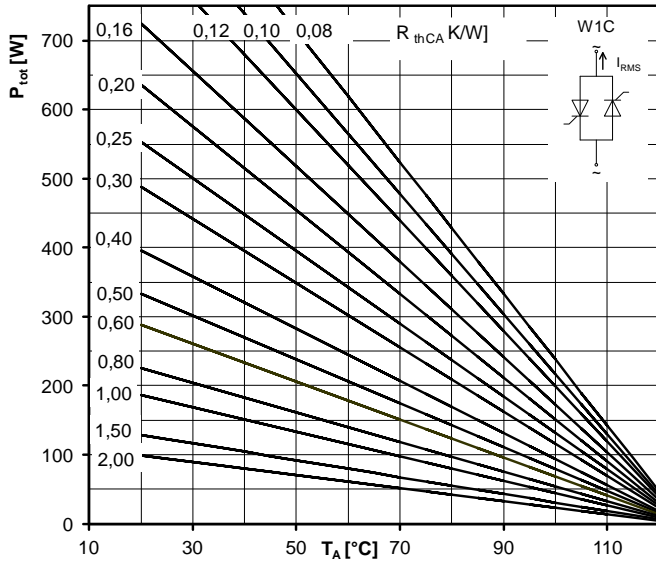
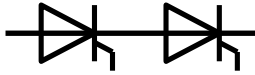
B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

Wärmewiderstand pro Element zwischen den Gehäusen und Umgebung /  
Thermal resistance per chip cases to ambient  $R_{thCA}$





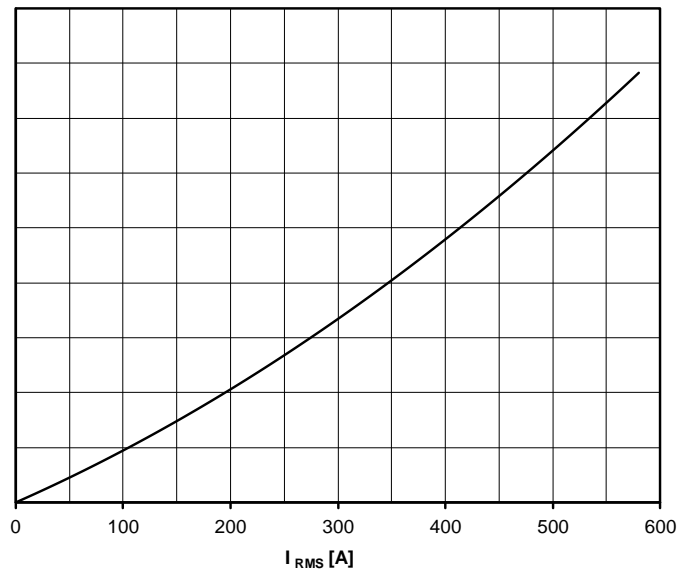
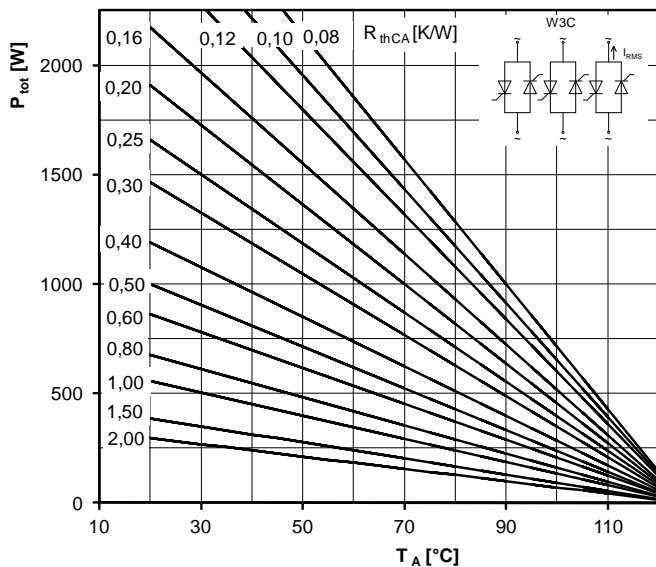
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current  $I_{RMS}$

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

Wärmewiderstand pro Element zwischen den Gehäusen und Umgebung /  
Thermal resistance per chip cases to ambient  $R_{thCA}$



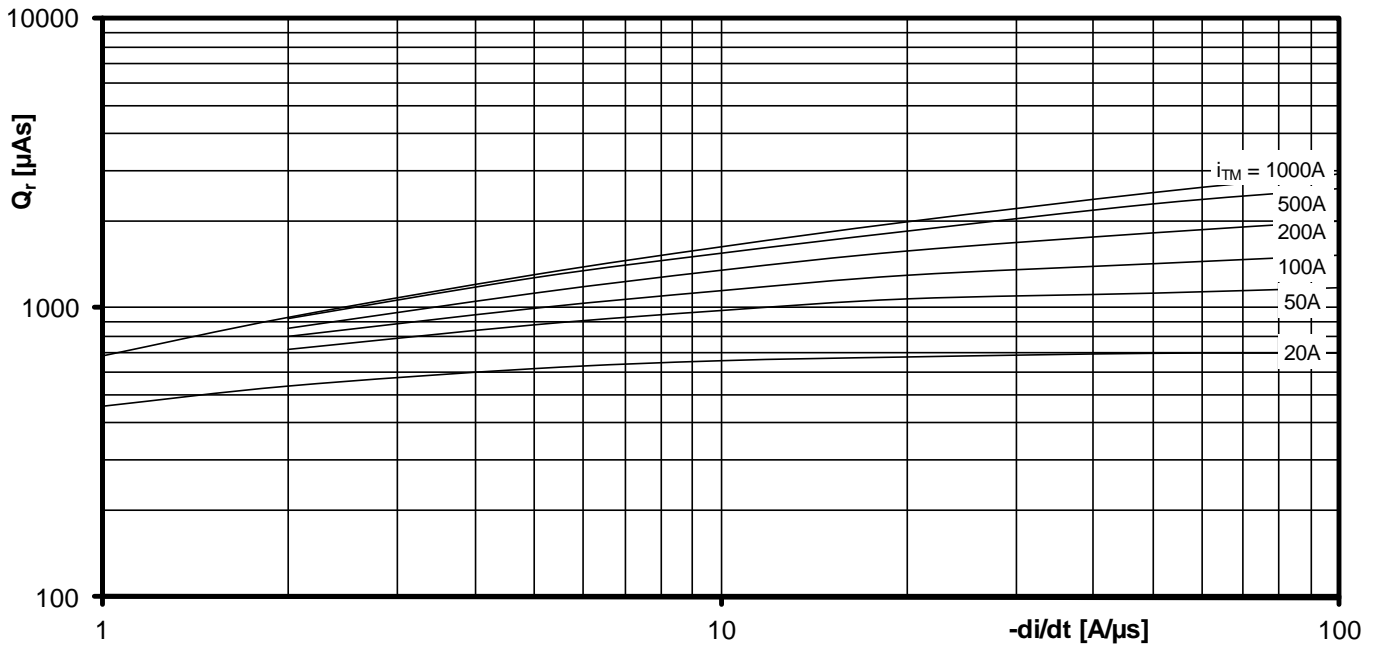
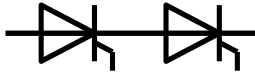
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current  $I_{RMS}$

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit  $P_{tot}$

Parameter:

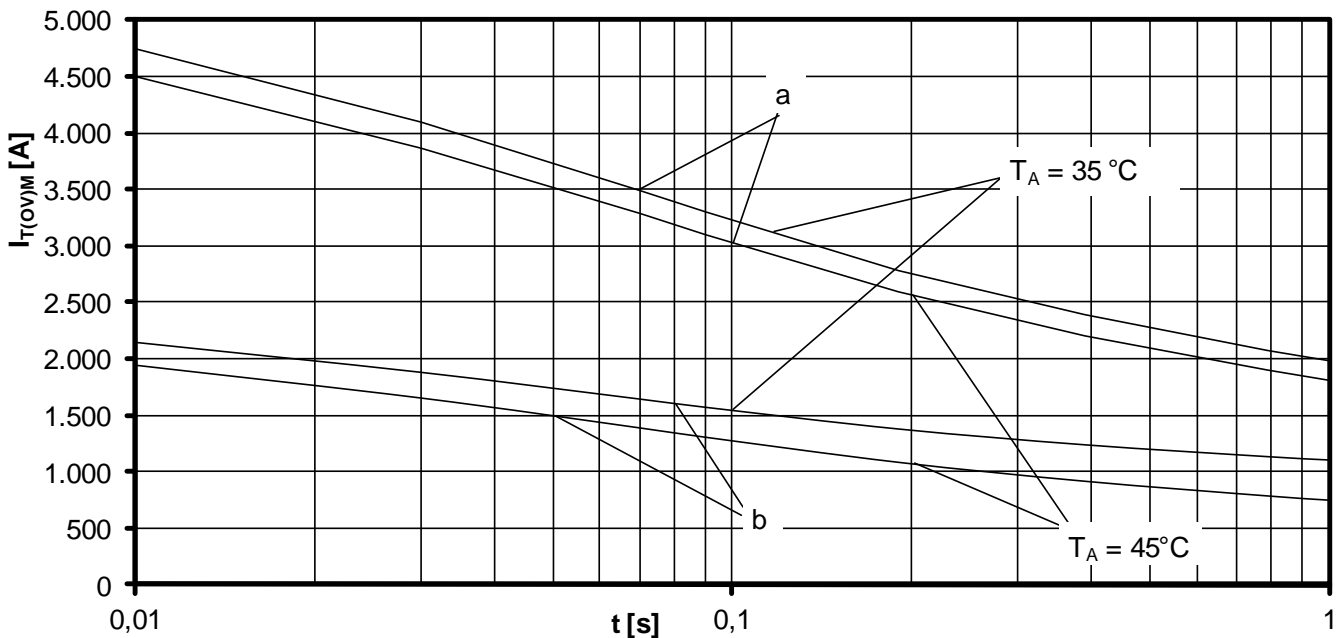
Wärmewiderstand pro Element zwischen den Gehäusen und Umgebung /  
Thermal resistance per chip cases to ambient  $R_{thCA}$



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, v_R \leq 0,5 V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$



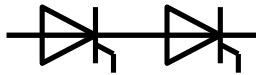
Grenzstrom / Maximum overload on-state current  $I_{T(OV)M} = f(t), v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

a: Leerlauf / No-load conditions

b: nach Belastung mit  $I_{TAVM}$  / after load with  $I_{TAVM}$

$T_A = 35^\circ\text{C}$ , verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling

$T_A = 45^\circ\text{C}$ , Luftselbstkühlung / Natural air cooling



## Technische Information / technical information



**Netz-Thyristor-Modul**  
**Phase Control Thyristor Module**

**TT250N**

Infineon Technologies Bipolar  
GmbH & Co. KG

### Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

### Terms & Conditions of usage

The product data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the specifications of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you. For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [SCR Modules](#) category:*

*Click to view products by [Infineon](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[DT430N22KOF](#) [T1401N42TOH](#) [T1851N60TOH](#) [T390N14TOF](#) [T420N12TOF](#) [T470N16TOF](#) [T640N16TOF](#) [T901N36TOF](#) [TD140N18KOF](#)  
[TD142N16KOF](#) [TD162N16KOF-A](#) [TD250N12KOF](#) [TD330N16AOF](#) [TT215N22KOF](#) [TZ310N20KOF](#) [TZ425N12KOF](#) [TZ500N12KOF](#)  
[T300N14TOF](#) [T3710N06TOF](#) [VT](#) [T390N16TOF](#) [T460N24TOF](#) [T501N70TOH](#) [T560N16TOF](#) [T640N14TOF](#) [TD250N14KOF](#)  
[TT600N16KOF](#) [TZ500N16KOF](#) [TZ240N36KOF](#) [TT210N12KOF](#) [NTE5710](#) [TD180N16KOF](#) [TT240N28KOF](#) [TZ425N14KOF](#)  
[T1081N60TOH](#) [TT61N08KOF](#) [TD251N18KOF](#) [TT162N08KOF](#) [TZ430N22KOF](#) [TT180N12KOF](#) [T2001N34TOF](#) [TD140N22KOF](#)  
[MDMA200P1600SA](#) [TT180N16KOF](#) [VS-ST333C08LFM0](#) [VS-ST180C14C0L](#) [T1080N02TOF](#) [TD320N16SOF](#) [T360N22TOF](#)  
[TZ810N22KOF](#) [T2563NH80TOH](#)